(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年7 月21 日 (21.07.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/066955 A1

(51) 国際特許分類7:

G11B 21/21,

5/60, B32B 15/08, H05K 1/05

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/019836

(22) 国際出願日: 2004 年12 月28 日 (28.12.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-000475 2004 年1 月5 日 (05.01.2004) JF

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 新日本製鎌株式会社 (NIPPON STEEL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008071 東京都千代田区大手町二丁目6番3号 Tokyo (JP). 新日鐵化学株式会社 (NIPPON STEEL CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1410031 東京都品川区西五反田7丁目21番11号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 莊司 浩雅 (SHO,JI, Hiromasa) [JP/JP]; 〒2938511 千葉県富津市新富 2 0 1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部内 Chiba (JP). 久保 祐治 (KUBO, Yuuji) [JP/JP]; 〒2938511 千葉県富津市新富 2 0 1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部内 Chiba (JP). 濱田 健 (HAMADA, Takeshi) [JP/JP]; 〒2938511 千葉県富津市新富 2 0 1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部内 Chiba (JP). 水野 珠美 (MIZUNO, Tamami) [JP/JP]; 〒2920835 千葉県木更津市築地 1 番地 新日鐵化学株式会社 電子材料研究所内 Chiba (JP). 岡村 一人 (OKAMURA, Kazuto) [JP/JP]; 〒2920835 千葉県木東津市築地 1 番

地 新日鐵化学株式会社 電子材料研究所内 Chiba (JP). 澤村 太三 (SAWAMURA, Tazo) [JP/JP]; 〒2920835 千葉県木更津市築地 1番地 新日鐵化学株式会社 電子材料研究所内 Chiba (JP).

- (74) 代理人: 青木 篤, 外(AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビ ル青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: BASE MATERIAL FOR HDD SUSPENSION

(54) 発明の名称: HDDサスペンション用基板材料

(57) Abstract: A base material for HDD suspension that excels in the adhesion between stainless steel foil and insulating resin layer and that through prevention of the diffusion of metal component of stainless steel into the insulating resin layer, retains high etching capability of the insulating resin. There is provided a base material for HDD suspension obtainable through stainless steel foil forming processing, characterized in that at least one major surface of the stainless steel foil is laminated with at least an insulating resin layer and a coating layer composed mainly of one or both of a metal hydroxide and metal oxide excluding chromium as a metal species.

(57) 要約: ステンレス箔と絶縁性樹脂層との優れた密着性を有し、且つ、ステンレス中の金属成分の絶縁性樹脂層への拡散を防ぐことにより、絶縁性樹脂の高いエッチング性能を保持するHDDサスペンション用基板材料が提供さ

(57)要約:ステンレス箔と絶縁性樹脂層との優れた密着性を有し、且つ、ステンレス中の金属成分の絶縁性樹脂層 への拡散を防ぐことにより、絶縁性樹脂の高いエッチング性能を保持するHDDサスペンション用基板材料が提供される。本発明のHDDサスペンション用基板材料は、ステンレス箔を成型加工してなるHDDサスペンション用基板材料は、ステンレス箔を成型加工してなるHDDサスペンション用基板材料であって、該ステンレス箔の少なくとも片側の表面上に、金属種としてクロムを除く金属酸化物又は金属水酸化物の一方または両方を主とした被膜層と、絶縁性樹脂層を少なくとも積層してなることを特徴とする。



明 細 書

HDDサスペンション用基板材料

技術分野

本発明は、絶縁性樹脂層との密着性に優れたHDDサスペンション 用基板材料に関する。

背景技術

ハードディスクドライブ(以下HDD)は、近年のパーソナルコンピュータの普及率増加や、家電やカーナビ等の各種アプリケーションへの新規搭載などに伴い、その生産量が軒並み増加している。HDDは、今後、大容量化や小型化が進むと予測され、HDDにおいて磁気を読み取るフレクシャーブランクを構成するサスペンション(以下HDDサスペンション)部分についてもまた、小型化及び配線の多線化、細線化が進むと考えられる。

ワイヤレスサスペンションは、金属層(導体層)/絶縁性樹脂層/金属層(支持層)から成る3層材であり、支持層として使用されるステンレス箔の板ばねに、絶縁層を挟んで直接銅配線が形成されている。高速で回転するディスク上をスキャンする際に、細かな振動と慣性力が加わる部材であるため、金属層と絶縁層との密着性が不可欠であり、また、部材の小型化や細線化が進むに従って、より一層の密着性が必要とされるようになる。

一方、積層体を構成する絶縁性樹脂層の形状加工においては、ウェットエッチング加工法又はドライエッチング加工法が用いられているが、絶縁性樹脂層へ金属層から金属成分が拡散することにより、樹脂の変性が起こる場合があり、エッチング加工速度の著しい低

下を招くため、問題となっている。特に、形状加工法の内で最も一般的なプラズマ法によるドライエッチング加工は、ランニングコストが高く加工費が割高となるため、エッチング速度低下による損害は大きい。

以上のような背景のもと、特開2001-207194号公報では、圧延後の洗浄においてフッ化物イオン濃度0.5~3mol/m³、pH2~4.2の水溶液により洗浄することを特徴とする、ポリイミド樹脂密着性に優れたステンレス箔圧延材の製造方法が報告されている。この技術により、圧延材の表面に残った圧延油や疎水性大気生成被膜等を化学処理によって効率的に除去することができ、密着性不良部を低減し、ステンレス箔とポリイミド樹脂の密着性が確保できるとされている。しかし、この密着性は十分ではなく、また金属成分の拡散抑制効果は全く期待できない。

以上に述べたように、絶縁層との密着性を高度に満足し、かつ金属成分の拡散抑制に効果のあるステンレス箔の表面処理は未だ開発されておらず、早急な開発が望まれていた。

発明の開示

本発明は、このような状況に鑑みたものであり、その目的は、ステンレス箔と絶縁性樹脂層との優れた密着性を有し、且つ、ステンレス中の金属成分の絶縁性樹脂層への拡散を防ぐことにより、絶縁性樹脂の高いエッチング性能を保持するHDDサスペンション用基板材料を提供することである。

本発明者らは、前記課題を解決する手段を鋭意検討した結果、ステンレス箔の少なくとも片側の表面上に、金属種としてクロムを除く金属酸化物又は金属水酸化物の一方または両方を主とした被膜層と、絶縁性樹脂層とを少なくとも積層してなることを特徴とするHD

Dサスペンション用基板材料が、ステンレス箔と絶縁性樹脂層との優れた密着性を有することを見出し、さらには一般的なエッチャントによる絶縁性樹脂のエッチングにおいて、その速度が低下しないことを見出し、本発明に至った。

本発明の趣旨とするところは、以下のとおりである。

- (1) ステンレス箔を成型加工してなるHDDサスペンション用基板材料であって、該ステンレス箔の少なくとも片側の表面上に、金属種としてクロムを除く金属酸化物又は金属水酸化物の一方または両方を主とした被膜層と、絶縁性樹脂層を少なくとも積層してなることを特徴とするHDDサスペンション用基板材料。
- (2) 前記被膜層の平均膜厚が5 μ m以下である前記(1)記載のHDDサスペンション用基板材料。
- (3) 前記被膜層のステンレス箔に対する被覆率が10%以上である前記(1)又は(2)に記載のHDDサスペンション用基板材料。
- (4) 前記被膜層がステンレス箔上に島状分布する前記(1)~(3)の いずれかに記載のHDDサスペンション用基板材料。
- (5) 前記被膜層にクラックが存在する前記(1)~(4)のいずれかに 記載のHDDサスペンション用基板材料。
- (6) 前記金属種がジルコニウム、チタン、ケイ素から選ばれる1種 又は2種以上である前記(1)記載のHDDサスペンション用基板材料。
- (7) 前記金属種がチタンである前記(1)記載のHDDサスペンション 用基板材料。
- (8) 前記被膜層を有するステンレス箔と絶縁性樹脂層との接着力が0.54kN/m以上である前記(1)記載のHDDサスペンション用基板材料
- (9) 前記ステンレス箔の厚みが $10\sim100~\mu$ mである前記(1)記載のHD Dサスペンション用基板材料。

(10) 前記絶縁性樹脂層の厚みが $1\sim150\,\mu$ mである前記(1)記載のHD Dサスペンション用基板材料。

- (11) 前記絶縁性樹脂層が耐熱性のポリイミド系樹脂である前記(1)記載のHDDサスペンション用基板材料。
- (12) 前記耐熱性ポリイミド系樹脂層が高熱膨張性ポリイミド/低熱膨張性ポリイミド/高熱膨張性ポリイミドの三層構造を成す前記(11)記載のHDDサスペンション用基板材料。
- (13) 前記耐熱性ポリイミド系樹脂層の線膨張係数が $1 \times 10^{-5} \sim 3 \times 10^{-5} / \mathbb{C}$ の範囲にある前記(12)記載のHDDサスペンション用基板材料
- (14) さらに前記絶縁性樹脂層の上に金属層を積層してなる前記(1)記載のHDDサスペンション用基板材料。

0

- (15) 前記金属層が金属箔である前記(14)記載のHDDサスペンション用基板材料。
- (16) 前記金属箔が表面処理された金属箔である前記(15)記載のHD Dサスペンション用基板材料。
- (17) 前記金属箔がステンレス箔又は銅箔である前記(15)又は(16) 記載のHDDサスペンション用基板材料。
- (18) 前記金属層と絶縁性樹脂層との接着力が0.54kN/m以上である前記(14)記載のHDDサスペンション用基板材料。
- (19) HDDサスペンションを構成するロードビーム用基板材料である前記(1)~(18)のいずれかに記載のHDDサスペンション用基板材料
- (20) HDDサスペンションを構成するフレクシャーブランク用基板 材料である前記(1)~(18)のいずれかに記載のHDDサスペンション用 基板材料。

本発明によると、ステンレス箔と絶縁性樹脂層との優れた密着性

を有するHDDサスペンション用基板材料の提供が可能となる。さらに、ロードビームやフレクシャーブランク等のHDDサスペンション材料への形状加工において、歩留まりや品質安定性が向上する。

発明を実施するための最良の形態

以下に、本発明を詳しく説明する。

本発明は、ステンレス箔を成型加工してなるHDDサスペンション 用基板材料であり、該ステンレス箔の少なくとも片側の表面上に、 金属種としてクロムを除く金属酸化物又は金属水酸化物の一方又は 両方を主とした被膜層と、絶縁性樹脂層を少なくとも積層したもの である。

本件の発明者らが鋭意検討した結果、ステンレス箔表面に金属酸 化物又は金属水酸化物の一方又は両方を主とした被膜層を有するこ とで、全くこのような処理を施さない場合よりも絶縁性樹脂との密 着性が向上することを見出した。この機構については明確ではない が、金属酸化物と金属水酸化物がその上に形成される絶縁性樹脂と 強固な化学結合を有することが原因ではないかと考えられる。さら に、金属酸化物又は金属水酸化物の一方又は両方を主とした被膜層 の被覆率が10%以上の場合、より密着性が向上することを見出した 。この機構についても明確ではないが、いわゆるアンカー効果に類 似の作用により向上したのではないかと考えられる。ここで、被覆 率とは、ステンレス箔の表面積に対する被覆層面積の割合である。 対象となる状態としては、低成膜量の場合によく見られる島状析出 や、充分な成膜量であるが被膜に下地まで達するクラックが存在す ることによるもの、島状析出部分にクラックが存在する場合等であ る。このような状態の場合、表面積増大やクラックへの樹脂食い込 みによるアンカー効果発現、及び化学結合に関与する面積増大のた

めに、密着性が向上するものと考えられる。被覆率10%未満では、これらの効果が十分に発現しない。更に、この被膜層の被覆率が10%以上の場合には、絶縁性樹脂のエッチング速度の低下が抑制されていることを確認した。これは、基材からの金属成分の拡散抑制によるものと考えられる。

金属酸化物又は金属水酸化物の一方又は両方を主とした被覆層の平均厚さは、 5μ m以下が好ましい。 5μ m超では密着性が飽和し経済的でなく、場合によっては性能が低下することがある。平均厚さの下限値は、被覆されていない部分があっても被覆されている部分の厚さが少なくとも単分子層あればよい。

積層する絶縁性樹脂層の厚さは $1\sim150\,\mu$ mであるのが好ましい。 $1\,\mu$ m未満では、電気的絶縁の信頼性が低下すると同時に、誘電特性が悪くなる可能性がある。 $150\,\mu$ mを超えると、高精度のパターニングが行い難いという問題が生じる。積層する絶縁性樹脂層の厚さは、より好ましくは $3\sim20\,\mu$ mである。

本発明のステンレス箔の上に形成される金属酸化物又は金属水酸化物の金属種は、クロムを除いて特に限定するものではないが、鉄、マグネシウム、ニオブ、タンタル、アルミニウム、ニッケル、コバルト、チタン、ジルコニウム、ケイ素等が挙げられる。この被覆層は、1種類の金属種で構成されても良いし、2種類以上の複合系、混合系や積層でも良い。特に好適な金属は、チタン、ジルコニウム、ケイ素である。これは、チタン、ジルコニウム、ケイ素の酸化物及び水酸化物が有機物と良好な結合を形成するためと考えている。また、クロムの酸化物又は水酸化物も密着性等への効果は確認しているが、成膜時に経由する可能性があるクロムイオンと被膜に残存する可能性があるクロムイオンの環境負荷への影響を考慮して、金属種としてクロムを除いた。ステンレス箔上に金属酸化物と金属水

酸化物の一方又は両方を形成する方法は、特に限定するものではなく、一般に公知の方法を適用することができる。例えば、金属のフルオロ錯イオン等のふっ化物イオンを用いる液相析出法やゾルゲル法等の液相法、スパッタリング法やCVD法等の乾式法等を挙げることができる。

金属板表面上に形成した金属酸化物又は金属水酸化物の被覆率制御やクラック形成方法は、特に限定するものではないが、例えば、研磨紙等による機械的な研削、急冷等のヒートショック、酸性水溶液、アルカリ性水溶液、ふっ化物イオン含有水溶液による化学的エッチング等を挙げることができる。勿論、成膜方法や成膜条件によっては、自ずとクラックが発生することもある。

本発明に適用できるステンレス箔は、特に制限されるものではないが、サスペンションに必要なばね特性や寸法安定性の観点から、SUS304が好ましい。ステンレス箔の好ましい厚さ範囲は $10\sim100\,\mu\,\mathrm{m}$ である。 $10\,\mu\,\mathrm{m}$ 未満では、積層体の反りが大きくなり易く、 HDD サスペンション用基板材料における支持体としての信頼性が損なわれる。 $100\,\mu\,\mathrm{m}$ 超では、剛性が大きく、 HDD サスペンション用基板材料としては適さない。

本発明の絶縁性樹脂種は、特に限定されるものではない。例えば、ポリイミド、ポリエチレン、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フッ素樹脂等である。耐熱性、難燃性、寸法安定性、耐薬品性等を考慮すると、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド等のイミド結合を構造中に有するポリマーからなるポリイミド系樹脂等が好ましい。勿論、ポリイミド系樹脂種も限定されない。絶縁性樹脂層の積層方法もまた限定されない。樹脂層の構造についても限定されず、単層であっても複数種のポリイミド系からなる多層構造であってもよいが、好ましくは三層構造をなし、ステン

レス箔或いは金属層と接する層(以下、接着層)のポリイミド系樹脂 として高熱膨張性ポリイミドを、ステンレス箔或いは金属層と接し ない層(以下、コア層)のポリイミド系樹脂として低熱膨張性ポリイ ミドを用いた、高熱膨張性ポリイミド樹脂層/低熱膨張性ポリイミ ド樹脂層/高熱膨張性ポリイミド樹脂層という三層構造がよい。こ の理由としては、接着層は、ステンレス箔或いは金属層との化学結 合の促進やアンカー効果による接着力発現のために、加熱時に可塑 性を有する事が必要である一方で、コア層は、樹脂層の寸法変化や 加工後の反りを抑制するために、低熱膨張性であることが必要であ ることが挙げられる。なお、二層の接着層の樹脂種は、互いに同一 であっても異なっていても良い。三層の厚みは限定されない。金属 酸化物又は金属水酸化物の一方又は両方を主とした被覆層の形状と して、島状析出したものや下地まで達するクラックを有するものが あるが、接着層がこの形状の高低差以上の厚みを有することが、樹 脂の食い込みに起因する接着性を十分に発現させるために好ましい 。ただし、接着層樹脂は、高熱膨張性樹脂であり、ポリイミド樹脂 層の寸法変化を増大させる因子となるため、必要以上に厚いことは 好ましくない。三層としての線膨張係数は1×10⁻⁵~3×10⁻⁵/℃が 好ましい。このように、ポリイミド系樹脂層を、低熱膨張性ポリイ ミド樹脂層と高熱膨張性ポリイミド樹脂層とを組み合わせて、多層 構造とすることによって、材料特性として低熱膨張性と高接着性の 両方を満足する樹脂層を形成することが可能となる。

また、必要に応じて、絶縁性樹脂層の上に、さらに金属層を積層しても良い。絶縁性樹脂層上に積層する金属層は、特に限定されるものではない。銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金等が挙げられる。また、金属箔であれば、ステンレス箔、銅箔、銅合金箔、アルミニウム箔、アルミニウム合金箔等が挙げられる。これら

金属箔については、接着力等の改良を目的として、化学的あるいは 機械的な表面処理を施してもよい。

上記被覆層を有するステンレス箔又は上記金属層と上記絶縁性樹脂層との接着力は、0.54kN/m以上であるのが好ましい。0.54kN/m未満では、HDDサスペンション用基板材料の製造工程であるエッチング等の処理において剥がれを生じる場合があり、また、使用環境下においては高速で回転するディスク上をスキャンする際の細かな振動や慣性力により不具合を生じやすくなる。

ロードビームやフレクシャー等のHDDサスペンション構成部材への加工も、特に限定されない。これらは、例えば、金属部分や絶縁性樹脂層部分をエッチングすることで加工される。

実施例

以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれ らの実施例によって何ら限定されるものではない。

[金属材料]

基板材料として、各種厚みのステンレス箔(SUS304)を用いた。 また、A1箔、Cu箔等も必要に応じて用いた。

[基板材料への被覆層の形成方法]

基板材料への金属酸化物及び金属水酸化物の付与は、液相析出法 又はスパッタ法によった。液相析出法の処理液としては、(1) 0.1m o1/Lへキサフルオロケイ酸アンモニウム水溶液、(2) 0.1mo1/Lへキ サフルオロチタン酸アンモニウム水溶液、又は(3) 0.1mo1/Lへキサ フルオロジルコン酸アンモニウム水溶液を用いた。ステンレス箔を 上記処理液へ浸漬し、アルミニウムを対極としたカソード電解によ り、金属酸化物及び金属水酸化物をステンレス箔上に成膜した。成 膜条件は、電流密度を100mA/cm²に制御して、室温で1~10分間の電

解とし、成膜後、水洗し、乾燥した。

また、スパッタ法は、Si、Ti、又はZrをターゲットとし、下地金属板上に金属酸化物を成膜した。

成膜した被覆層について、X線光電子分光法と赤外線分光法により、金属酸化物及び金属水酸化物の生成を確認した。

[絶縁性樹脂]

絶縁性樹脂は、以下のポリイミド前駆体溶液を使って作製した。まず、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン292.3g(1mo1)を5Lのセパラブルフラスコ中で攪拌しながら、3690.0gのN,N-ジメチルアセトアミドを溶解させた。この溶液を氷浴で冷却しながら、窒素気流中で3,3',4,4'-ジフェニルスルフォンテトラカルボン酸二無水物358.3g(1mo1)を加えた。この溶液を室温に戻して、3時間攪拌を続けて重合させて、ポリイミド前駆体溶液Aを得た。

次に、4,4' -ジアミノ-2' -メトキシベンズアニリド154.4g(0.6m o1)と4,4' -ジアミノジフェニルエーテル80.1g(0.4mo1)を5Lのセパラブルフラスコ中で攪拌しながら、2560.0gのN,N-ジメチルアセトアミドを溶解させた。この溶液を氷浴で冷却しながら、窒素気流中でピロメリット酸二無水物218.1g(1mo1)を加えた。この溶液を室温に戻して、3時間攪拌を続けて重合させて、ポリイミド前駆体溶液Bを得た。

さらに、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン292.3g(1mo1)を5Lのセパラブルフラスコ中で攪拌しながら、3530.0gのN,N-ジメチルアセトアミドを溶解させた。この溶液を氷浴で冷却しながら、窒素気流中で3,3',4,4'-ジフェニルスルフォンテトラカルボン酸ニ無水物286.6g(0.8mo1)とピロメリット酸ニ無水物43.6g(0.2mo1)を加えた。この溶液を室温に戻して、3時間攪拌を続けて重合させて、ポリイミド前駆体溶液Cを得た。

[作製試料の評価方法]

(1) 密着性評価

目的とする界面の密着性評価は、目的とする界面を構成する金属材料に、幅3.2mmの直線状のパターニングを施し、測定用サンプルを作成した後、ポリイミド樹脂層側を固定板に貼り付け、目的とする界面のみが剥離するように引張試験機(東陽精機株式会社製、ストログラフーMI)を用いて、目的とする界面を構成する金属材料を90°方向に引き剥がした際の接着力を測定することで行った。評価基準は、測定した接着力が0.54kN/m以上をA、0.54kN/m未満をBとした。

(2) 被覆層の被覆率測定

基板材料上に形成した被覆層の被覆率は、次のようにして求めた。走査型電子顕微鏡を用いて、倍率10000倍で観察後、画像処理により下地金属と被覆層を区別して、その比率を求め、これを任意の5箇所について行い、その平均を被覆率とした。

(3) エッチング性能評価

ステンレス箔上に形成したポリイミド樹脂層のエッチング性能を評価した。試料を50℃の100%水加ヒドラジンに浸漬して、ポリイミド樹脂層のエッチング速度の比較をした。無処理のステンレス箔上に形成したポリイミド樹脂層のエッチング速度を基準とし、これよりエッチング速度が速い場合をA、同等の場合をB、遅い場合をCとした。

例1

厚さ $10 \mu m$ のステンレス箔上に、表1に示す条件で各種被覆層を形成した。また、比較材として、無処理のステンレス箔も用いた。

次に、これら試料の表面に各種厚みのポリイミド樹脂層を形成した。樹脂層の合計厚みを10 μmとする場合の形成方法は、試料表面

に、硬化後の膜厚が 1μ mとなるように、上述のポリイミド前駆体溶液Aを塗布して、130 C、4分間乾燥した。次に、この上に、上述のポリイミド前駆体溶液Bを硬化後の二層膜厚が 9μ mとなるように塗布して、130 C、8分間乾燥した。さらに、上述のポリイミド前駆体溶液Cを硬化後の三層膜厚が 10μ mとなるように塗布して、130 C、4分間乾燥した。このように、ポリイミド樹脂層を三層積層した試料を、窒素気流中で最高到達温度が360 Cとなる条件で熱処理を行い、樹脂層の硬化を完了させた。

このようにして得られた各種試料について、上述の評価試験を行った。結果を表1に示す。

表 1

		_						_			_	_				_			_		
舗券		実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例						
果	エッチング速度	A	А	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
評価結果	密着性	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
絶縁性樹 脂	膜厚/μm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.5	1	10	30
	膜厚/ mm	5	4	3	2		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	被膜の状態	1	_	1	1	1		1	カラック	カラック	カラック	島状、クラック	島状、クラック	島状、クラック	島状	島状	島状	クラック	カラック	カラック	クラック
10 μ m) への処理	被覆率/%	100	100	100	100	100	100	100	06	80	70	09	50	40	30	20	10	70	70	70	70
	酸化物種	$Si0_2$	SiO_2	$Si0_2$	SiO_2	SiO_2	$Si0_2$	${ m Ti0}_2$	$Ti0_2$	$2r0_2$	$Zr0_2$	$Zr0_2$	$Zr0_2$								
₹(SUS30	処理液	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)
ステンレス箔(SUS304、	形成方法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法						
No.	<u>.I</u>	H	2	က	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

半1 (しんが)

	備考		実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	比較例
	串	エッチング速度	А	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	基準
	評価結果	密着性	A	A	A	A	А	A	А	A	A	A	A	A	A	В
	絶縁性樹 脂	膜厚/ μ m	50	20	06	110	130	150	170	10	10	10	10	10	10	10
\		膜厚/μm	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1
		被膜の状態	カラッカ	カラック	カラッカ	カラッカ	カラッカ	カラック	カラック	カラッカ	カラック	カラッカ	_	1	_	1
4	の処理	被覆率/%	70	02	20	20	70	20	20	20	20	02	100	100	100	
	04、10μm)〜の処理	酸化物種	$\mathrm{Zr}0_{2}$	$\mathrm{Zr}0_2$	$\mathrm{Zr}0_{2}$	$\mathrm{Zr}0_{2}$	$Zr0_2$	$Zr0_2$	$\mathrm{Zr}0_2$	$Si0_2 + Ti0_2$	$\mathrm{Ti}0_2$ + $\mathrm{Zr}0_2$	$\mathrm{SiO_2+ZrO_2}$	$\mathrm{Si0}_{2}$	${ m Ti0}_2$	$\mathrm{Zr}0_2$	1
	筲(SUS304.	処理液	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(1)+(2)	(5)+(3)	(1)+(3)	1	1	1	1
	ステンレス箱(SUS3	形成方法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	スパッタ法	スペッタ法	スパッタ法	無処理
	No.		21	22	23	24	25	<u> 2</u> 6	22	78	53	30	31	32	33	34

被覆層の成膜方法によらず、被覆層を形成したステンレス箔は、何れも無処理のステンレス箔よりも絶縁性樹脂層との密着性に優れていた。また、樹脂層のエッチング性能も無処理ステンレス箔と同等以上であった。

例 2

厚さ $10 \, \mu$ mの銅箔の表面に各種厚みのポリイミド樹脂層を形成した。樹脂層の合計厚みを $10 \, \mu$ mとする場合の形成方法は、試料表面に硬化後の膜厚が $1 \, \mu$ mとなるように、上述のポリイミド前駆体溶液Aを塗布して、 $130 \, \mathbb{C}$ 、4分間乾燥した。次に、この上に上述のポリイミド前駆体溶液Bを硬化後の二層膜厚が $9 \, \mu$ mとなるように塗布して、 $130 \, \mathbb{C}$ 、8分間乾燥した。さらに、上述のポリイミド前駆体溶液Cを硬化後の二層膜厚が $10 \, \mu$ mとなるように塗布して、 $130 \, \mathbb{C}$ 、4分間乾燥した。このように、ポリイミド樹脂層を3層積層した試料を、窒素気流中で最高到達温度が $360 \, \mathbb{C}$ となる条件で熱処理を行い、樹脂層の硬化を完了させた。

一方、厚さ $100 \, \mu \, \mathrm{m}$ のステンレス箔上に、表2に示す条件で各種被 覆層を形成した。また、比較材として、無処理のステンレス箔も準 備した。

上記銅箔上に形成した樹脂層とステンレス箔の処理面が向き合うように重ね合わせた後、真空プレス機を用いて面圧100kg/cm²、温度320℃、プレス時間60分間の条件で加熱圧着した。

このようにして得られた各種試料について、上述の評価試験を行った。結果を表2に示す。

	備城	C nila	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	比較例
-	評価結果	密着性	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Α,	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	В
	絶縁性樹脂	膜厚/ μm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.5	1	10	30	50	20	90	110	130	150	170	10	10	10	10
		膜厚/μm	5	4	3	2	1		0.5			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1
		被膜の状態	1	1		-				4 で 5 4	カラック	カラック	島状、クラック	島状、クラック	島状、クラック	島状	島状	島状	4664	クラック	カラック	カラック	4664	カラック	4664	カラッカ	クラック	クゲラック	4664	1	1	1	; ; ;
	理	被覆率/%	100	100	100	100	100	100	100	06	80	70	09	50	40	30	20	10	20	70	20	02	70	70	20	02	70	70	02	100	100	100	
	100mm)への処理	酸化物種	SiO_2	SiO_2	$\mathrm{Si0}_{2}$	$\mathrm{Si0}_2$	SiO_2	$Si0_2$	${ m Ti0}_2$	${ m Ti0}_2$	${ m Ti0}_2$	${ m Ti0_2}$	${ m Ti0}_2$	$Ti0_2$	${ m Ti0}_2$	${ m Ti0}_2$	${ m Ti0}_2$	TiO_2	$\mathrm{Zr0}_2$	$2r0_2$	$2r0_2$	$2r0_2$	$\mathrm{Zr0}_2$	$Zr0_2$	$2r0_2$	$2r0_2$	$Zr0_2$	$2r0_2$	$\mathrm{Zr0}_2$	SiO_2	$Ti0_2$	$2r0_2$	1
	ス箔(SUS304、]	処理液	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	1	1	1	
	ステンレス箱	成膜方法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	液相析出法	スパッタ法	スパッタ法	スパッタ法	無処理
	M	0 1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	20	51	52	53	54	55	56	57	28	29	09	61	62	63	64	65

被覆層の成膜方法によらず、被覆層を形成したステンレス箔は、 何れも無処理のステンレス箔よりも絶縁性樹脂層との密着性に優れ ていた。

さらに、No.35~64のサンプルについて、ロードビームやフレクシャーの形状にエッチング加工して、外観を確認した。その結果、全てのサンプルについて、精度良く加工可能であることが確認された。

例3

表 $10\,\mathrm{No.10}$ と同条件で処理した厚さ $10\,\mu\,\mathrm{m}$ のポリイミド層を有する $10\,\mu\,\mathrm{m}$ ステンレス箔に対して、表3で示す条件で、ポリイミド樹脂表面上に金属層を形成した。 $10\,\mu\,\mathrm{m}$ 厚さの $\mathrm{A1}$ 箔(No.71)、 Cu 箔(No.75)の表面処理方法の詳細は、それぞれ、表 $10\,\mathrm{No.10}$ 、 $20\,\mathrm{と}$ 同じ酸化物層形成条件で行った。

このようにして得られた各種試料について、上述の評価試験を行った。結果を表3に示す。

表3

	理	C, HA		実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例
評価結果		左記金属層との密着性		В	В	В	А	A	A	В	A	A	A
絶縁性樹脂		膜厚/ μm		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	1 日本	真空蒸着	真空蒸着	熱圧着(実施例2と同条件)	熱圧着(実施例2と同条件)	熱圧着(実施例2と同条件)	熱圧着(実施例2と同条件)	熱圧着(実施例2と同条件)	熱圧着(実施例2と同条件)	熱圧着(実施例2と同条件)	熱圧着(実施例2と同条件)		
	关于 里豆片 书 乡 垂 四 ~	金属箱の表面処理力法		1		無処理	粗化処理(ショットブラスト)	粗化処理(電解エッチング)	液相析出法(TiO ₂)	無処理	粗化処理(ショットブラスト)	粗化処理(電解エッチング)	液相析出法(Zr0 ₂)
金属			新 踏 種	A1	Cu	A1缩	A1缩	A1绺	A1缩	Cu缩	Cu缩	Cu缩	75 Cu箔
	;	N		99	29	89	69	2	71	72	73	74	75

いずれも積層体形成が確認された。また、表面処理した金属箔においては、絶縁性樹脂層との密着性に優れていた。

さらに、No.73~75のサンプルについて、ロードビームやフレクシャーの形状にエッチング加工して、外観を確認した。その結果、全てのサンプルについて、精度良く加工可能であることが確認された。

請求の範囲

1. ステンレス箔を成型加工してなるHDDサスペンション用基板材料であって、該ステンレス箔の少なくとも片側の表面上に、金属種としてクロムを除く金属酸化物又は金属水酸化物の一方または両方を主とした被膜層と、絶縁性樹脂層を少なくとも積層してなるHDDサスペンション用基板材料。

- 2. 前記被膜層の平均膜厚が5μm以下である請求項1記載のHDDサスペンション用基板材料。
- 3. 前記被膜層のステンレス箔に対する被覆率が10%以上である 請求項1又は2に記載のHDDサスペンション用基板材料。
- 4. 前記被膜層がステンレス箔上に島状分布する請求項1~3のいずれかに記載のHDDサスペンション用基板材料。
- 5. 前記被膜層にクラックが存在する請求項1~4のいずれかに記載のHDDサスペンション用基板材料。
- 6. 前記金属種がジルコニウム、チタン、ケイ素から選ばれる1種又は2種以上である請求項1記載のHDDサスペンション用基板材料
- 7. 前記金属種がチタンである請求項1記載のHDDサスペンション 用基板材料。
- 8. 前記被膜層を有するステンレス箔と絶縁性樹脂層との接着力が0.54kN/m以上である請求項1記載のHDDサスペンション用基板材料。
- 9. 前記ステンレス箔の厚みが $10\sim100~\mu$ mである請求項1記載のHDDサスペンション用基板材料。
- 10. 前記絶縁性樹脂層の厚みが1~150 μ mである請求項1記載のHD Dサスペンション用基板材料。

11. 前記絶縁性樹脂層が耐熱性ポリイミド系樹脂である請求項1 記載のHDDサスペンション用基板材料。

- 12. 前記耐熱性ポリイミド系樹脂層が高熱膨張性ポリイミド/低熱膨張性ポリイミド/高熱膨張性ポリイミドの三層構造を成す請求項11記載のHDDサスペンション用基板材料。
- 13. 前記耐熱性ポリイミド系樹脂層の線膨張係数が1×10⁻⁵~3×10⁻⁵/℃の範囲にある請求項12記載のHDDサスペンション用基板材料。
- 14. さらに前記絶縁性樹脂層の上に金属層を積層してなる請求項 1記載のHDDサスペンション用基板材料。
- 15. 前記金属層が金属箔である請求項14記載のHDDサスペンション用基板材料。
- 16. 前記金属箔が表面処理された金属箔である請求項15記載のHD Dサスペンション用基板材料。
- 17. 前記金属箔がステンレス箔又は銅箔である請求項15又は16記載のHDDサスペンション用基板材料。
- 18. 前記金属層と絶縁性樹脂層との接着力が0.54kN/m以上である 請求項14記載のHDDサスペンション用基板材料。
- 19. HDDサスペンションを構成するロードビーム用基板材料である請求項1~18のいずれかに記載のHDDサスペンション用基板材料。
- 20. HDDサスペンションを構成するフレクシャーブランク用基板 材料である請求項1~18のいずれかに記載のHDDサスペンション用基 板材料。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019836

	IFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ G11B21/21, G11B5/60, B32B15/	08. H05K1/05												
1110.														
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC													
	SEARCHED													
Minimum do Int.(cumentation searched (classification system followed by classification sys	lassification symbols) 0, B32B1/00-35/00, H05K	1/00-1/02,											
Jitsu Kokai	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)													
Electronic da	ta base consulted during the international search (name of	data base and, where practicable, search te	erms used)											
C. DOCUN	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT													
Category*			Relevant to claim No.											
Y	WO 1996/022597 A1 (Nippon St Ltd.), 25 July, 1996 (25.07.96), Page 10, line 15 to page 11, lines 2 to 4; table 1 & US 6303230 B1	eel Chemical Co.,	1-3,6-20											
Y	JP 11-348179 A (Mitsui Chemi 21 December, 1999 (21.12.99), Par. Nos. [0007] to [0011] (Family: none)	1-3,6-20												
Y	JP 2000-123512 A (Ube Indust 28 April, 2000 (28.04.00), Par. Nos. [0008] to [0009] (Family: none)	ries, Ltd.),	1-3,6-20											
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.												
"A" docume to be of	categories of cited documents: nt defining the general state of the art which is not considered particular relevance	"T" later document published after the inte- date and not in conflict with the applica the principle or theory underlying the in	tion but cited to understand											
"E" earlier a filing da	pplication or patent but published on or after the international te	"X" document of particular relevance; the closed considered novel or cannot be considered."												
cited to	nt which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the cl	aimed invention cannot be											
-	eason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	considered to involve an inventive s combined with one or more other such	tep when the document is documents, such combination											
	nt published prior to the international filing date but later than the date claimed	being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family												
	ctual completion of the international search	Date of mailing of the international search												
22 Ma	arch, 2005 (22.03.05)	12 April, 2005 (12.	U4.U5)											
	ailing address of the ISA/	Authorized officer												
Japar	nese Patent Office													
Facsimile No		Telephone No.												

国際調査報告 国際出願番号 PCT/JP2004/019836 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. C1' G11B21/21, G11B 5/60, B32B15/08, H05K1/05 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. $C1^7$ G11B21/21, G11B 5/60, B29D9/00, B32B1/00-35/00H05K1/00-1/02, H05K1/05, H05K3/44最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2005年 日本国実用新案登録公報 1996-2005年 日本国登録実用新案公報 1994-2005年 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) C. 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 WO 1996/022597 A1 (新日鐵化学株式会社) 19 Y 1-3, 6-20 96.07.25, 第10頁第15行-第11頁第8行, 第20 頁第2-4行及び第1表 & US 6303230 B1 Y JP 11-348179 A (三井化学株式会社) 1999. 1 1-3, 6-202. 21, 段落【0007】-【0011】(ファミリーなし) JP 2000-123512 A (宇部興産株式会社) 200 Y 1-3, 6-200. 04. 28, 段落【0008】-【0009】(ファミリーな し) ____ C欄の続きにも文献が列挙されている。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 文献 (理由を付す) よって進歩性がないと考えられるもの 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 22.03.2005 12. 4. 2005 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 9653 日本国特許庁(ISA/JP) 鈴木 重幸 郵便番号100-8915

電話番号 03-3581-1101 内線 3590

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号